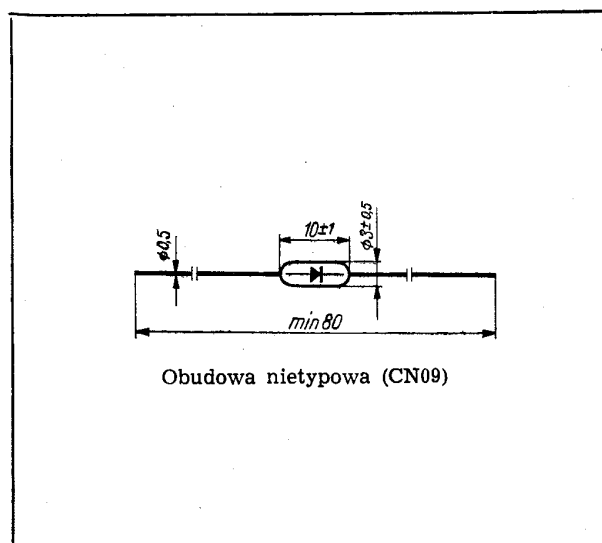


SWW 1156-131

Diody krzemowe epiplanarne.

Diody BAY54 i BAY55 są przeznaczone do stosowania w układach przełączających o bardzo dużej szybkości działania.

Diody BAP661 są przeznaczone do stosowania w układach detekcyjnych.



DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne wartości parametrów eksploatacyjnych

		BAP661	BAY54 i 55	
Napięcie wsteczne	U_R	25	50	V
Szczytowe napięcie wsteczne	U_{RM}	30	50	V
Prąd przewodzenia	I_F	100	115	mA
Szczytowy prąd przewodzenia	I_{FM}	180	225	mA
Temperatura złącza	t_j	423 K (150°C)		
Zakres temperatury składowania	t_{stg}	218...423 K (-55...+150°C)		

Parametry statyczne; $t_{amb} = 298$ K (25°C)

		min.	typ.	maks.	
Napięcie przewodzenia					
przy $I_F = 50$ mA					
dla BAY55	U_F	—	0,9	1	V
BAY54		—	1,1	1,2	V
$I_F = 15$ mA					
dla BAP661		—	0,8	1	V
Prąd wsteczny					
przy $U_R = 30$ V					
dla BAY54 i 55	I_R	—	1,5	50	nA
$U_R = 25$ V					
dla BAP661		—	50	500	nA
$U_R = 30$ V					
dla BAY54 i 55		—	1	50	μA
$U_R = 25$ V					
dla BAP661;					
$t_{amb} = 632$ K (150°C)		—	5	50	μA
Napięcie przebicia					
przy $I_R = 5$ μA					
dla BAY54 i 55	$U_{(BR)}$	50	70	—	V
$I_R = 100$ μA					
dla BAP661		30	45	—	V

Parametry dynamiczne; $t_{amb} = 298$ K (25°C)

		min.	typ.	maks.	
Czas przełączania					
dla BAY54 i 55					
przy $I_F = 10$ mA;					
$t_{rr} = 1$ mA; $U_R = 6$ V; t_{rr}					
$R_L = 100$ Ω		—	1,8	2	ns
Ładunek magazynowany dla					
dla BAY54 i 55	Q_s				
przy $I_F = 10$ mA;					
$U_R = 5$ V		—	35	—	pC
Pojemność diody					
dla BAY54 i 55	C_T				
przy $f = 1$ MHz;					
$U_R = 0$		—	1	2	pF
Sprawność detekcji					
dla BAP661					
przy $f = 35$ MHz;					
$U_{eff} = 3$ V;					
$R = 100$ kΩ;					
$C = 150$ pF		—	85	—	%